Научная программа
XI Международной научно-технической конференции
«**Микро- и нанотехнологии в электронике**»
3 – 8 июня 2019 г.

3 июня 2019 г.
Регистрация участников конференции

Дата – 4 июня 2019 г.
Название секции – Секция 1. **Физико-химические свойства материалов и структур микро- и наноэлектроники.**
Краткое описание секции: Заявленные на конференцию доклады посвящены исследованиям электрических, электрофизических, магнитных, физико-химических и теплофизических свойств диэлектрических, полупроводниковых и проводниковых элементарных материалов и сложных химических соединений как для объемных материалов, так и для пленок микронных и нанометровых толщин.
Председатели: Шебзухов Азамат Любович, д.ф.-м.н., проф., зав. каф. физических основ микро- и наноэлектроники, Нальчик
Попов Анатолий Игоревич – д.т.н., проф., НИУ МЭИ, Москва

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)	ФИО докладчика	Название доклада
Пленарный доклад	**Попов А.И.** проф. НИУ МЭИ (Москва)	1. Влияние степени упорядочения атомной структуры на свойства полупроводниковых материалов
Пленарный доклад	**Вахрушев С.Б.** ГНС ФТИ им. А. Ф. Иоффе., д.ф.-м.н. (Санкт-Петербург).	2. Новый метод исследования динамики решетки: неупругое рассеяние синхротронного излучения
Устный доклад	**Шебзухов А.А.**, Шебзухова М.А., Бжихатлов К.Ч.	3. О размерной зависимости поверхностного натяжения наночастиц в неизотермических условиях
Устный доклад	**Попов А.И.**, Шупегин М.Л.	4. Частотные зависимости диэлектрических свойств аморфных кремний-углеродных пленок
Устный доклад	**Кахраманов К.Ш.**, Кахраманов С.Ш., Азимова С. Бадалова З.И.	5. Дефектные центры снижающие теплопроводность легированного теллурида висмута
Устный доклад	**Маскаева Л. Н.**, Марков В.Ф.	6. Исследование оптических свойств тонких пленок PbS, легированных галогенидами кадмия
Устный доклад	Гавриков М.В., **Жуков Н.Д.**	7. СТМ-исследование нестабильности проводимости квантовой точки.
Устный доклад	**Мусаев А.А.**	8. Исследование электрофизических свойств сплавов Bi–Sb
Устный доклад	**Екимова И.А.**, Минакова Т.С., Смирнов Г.В., Тимофеева Л.П.	9. Методы и подходы к изучению свойств поверхности оксидных наноматериалов
Устный доклад	**Ахмедова Ш.А.**, Садыхова А.А., Мехтиев Т.Р.	10. Анализ Крамерс-Кронига спектров диффузного отражения ферритов Ni1-xZnxFe204

Устный доклад	**Петров В.В.**, Варзарев Ю.Н., Каменцев А.С., Старникова А.Н.	11. Газочувствительные и электрофизические свойства наноразмерных материалов на основе оксида цинка
Устный доклад	**Сайпулаева Л.А.**, Гаджиалиев М.М., Алибеков А.Г.	12. Гальваномагнитные эффекты в Cd3As2+MnAs при высоком давлении
Устный доклад	**Садыхова А.А.**, Шахла А.А., Телет Р.М.	13. ИК-спектры диффузного отражения нанопорошков Ni1-xZnxFe2O4
Устный доклад	**Гаджиев Г.Г.**, Омаров З.М., Магомедов М.-Р.М., Амирова А.А., Резниченко Л.А.	14. Теплофизические свойства керамики Na0,85Li0,125 NbO3 при высоких температурах
Устный доклад	Жук С., **Кистанов А.**, Дмитриев С.	15. Фотовольтаические свойства Cu2TiSnS4 и Cu2VSnS4
Устный доклад	**Абдуллаев Н.А.**, Гамзаева А.Ю., Ализаде Э.Г., Аждаров Г.Х., Мамедов Н.Т., Алигулиева Х.В., Кахраманов К.Ш.	16. Оптические свойства нанокомпозитов – полиэтилен низкой плотности (LDPE) с нанокристаллитами Bi2Te3
Устный доклад	**Старцев Ю. К.**, Фирсанова Т.В.	17. Физико-химические особенности дисплейных стекол для защиты портативных мониторов
Устный доклад	Аскеров Ш.Г., **Абдуллаева Л.К.**, Гасанов М.Г., Агамалиева Л.Ф.	18. Анализ влияния неоднородности поверхности на свойства контакта металл-полупроводник на основе теории сложных систем
Устный доклад	**Фомин В.М.**, Кобелева С.П., Анфимов И.М., Юрчук С.Ю., Турутин А.В.	19. Особенности диффузии фосфора в сильно легированном галлием германии
Устный доклад	**Рагимов С.С.**, Мусаев М.А., Ганымова Н.Н.	20. Электрофизические свойства $(AgSbTe_2)_{0.8}(PbTe)_{0.2}$
Устный доклад	**Магомедов М.Н.**	21. Изменение термодинамических свойств твердого раствора Si-Ge при изобарическом уменьшении размера нанокристалла
Стендовый доклад	Кабанов В.Ф., **Гавриков М.В.**, Жуков Н.Д.	22. Исследование свойств коллоидных и травленных квантовых точек антимонида индия
Стендовый доклад	**Салманов В.М.**, Гуссейнов А.Г., Мамедов Р.М., Казымзаде А.Г., Рагимов С.С.	23. Получение и свойства структуры InSe(наночастица)-InSe(кристалл)
Стендовый доклад	Атлуханова Л.Б., **Козлов Г.В.**	24. Влияние связности каркаса нанонаполнителя на структуру и свойства нанокомпозитов полиуретан / углеродные нанотрубки
Стендовый доклад	**Мирошников Б.Н.**, Баринов А.Д., Мирошникова И. Н., Варланов И.Б., Попов И.А.	25. Морфология фоточувствительных слоев на основе керамической супраструктуры Pb-Cd-S–O
Стендовый доклад	**Роках А.Г.**	26. Фотопроводимость слоев на основе квантовых точек CdS-PbS в сравнении с пленками ограниченных твердых растворов аналогичного состава
Стендовый доклад	**Здравомыслова Л.Х.**	27. Диэлектрическая проницаемость и проводимость в неоднородных средах
Стендовый доклад	**Здравомыслова Л.Х.**	28. Эффект Купса при поляризации неоднородных веществ

Стендовый доклад	**Ягудин И.Т.**, Жуков Н.Д.	29. Исследование фотопроводимости мультизеренной структуры на основе квантовых точек узкозонных полупроводников
Стендовый доклад	Рагимов С.С., **Агаева Г.И.**	30. Влияние элемента цинка на флуктуационную проводимость $Bi_2Sr_2CaCu_2OX$
Стендовый доклад	Агалиева С.Т., **Абдулзаде Н.Н.**, Мурсакулов Н.Н., Ширинов М.М.	31. Механизмы токопрохождения в барьерных наноструктурах Au/p+GaAs/p-AlGaAs/GaAs/n-AlGaAs в широком температурном интервале
Стендовый доклад	**Агалиева С.Т.**, Абдулзаде Н.Н., Мурсакулов Н.Н., Ширинов М.М.	32. Электрические и фотоэлектрические свойства наноструктурных $Ga_{1-x}In_xAs_{1-y}P_y$/p-AlGaAs
Стендовый доклад	**Перепечина Т.А.**, Рембеза С.И., Рембеза Е.С., Свистова Т.В.	33. Чувствительность наноструктурированных пленок SnO_2 к газам-окислителям
Стендовый доклад	**Миронюк В.Н.**, Глуховской Е.Г.	34. Влияние температурной обработки на туннельные вольтамперные характеристики квантовых точек CdSe
Стендовый доклад	**Исмаилов Ш.С.**, Селим-заде Р.И.,Рагимов С .С., Абдурахманова В.А.	35. Электропроводность и подвижность носителей заряда в твердых растворах $Ce_xSn_{1-x}Se$
Стендовый доклад	**Эмиров С.Н.**, Бейбалаев В.Д., Гаджиев Г.Г., Амирова А.А., Аливердиев А.А.	36. О температурных и барических зависимостях теплопроводности композитных материалов
Стендовый доклад	**Алиханов Н.М-Р.**, Эмиров Р.М., Рабаданов М.Х.	37. Диэлектрические свойства керамики $Bi_{1-x}Sm_xFeO_3$
Стендовый доклад	**Березов А.В.**, Валиева Д.И., Туриев А.М.	38. Фотолюминесценция тонких пленок фталоцианина никеля
Стендовый доклад	**Кодзасова Т.Л.**, Кодзасов В.А., Аллаяров А.Н., Ширяев А.В., Дедегкаева Л.М.	39. Исследование свойств фотонных кристаллов на основе пористого оксида алюминия
Стендовый доклад	**Шебзухов М.Д.**	40. Экспериментальные исследования фотоэмиссионных свойств бинарной системы натрий-цезий (переизлучение падающего монохроматического пучка света)
Стендовый доклад	**Бобылев А.Н.**, Удовиченко С.Ю.	41. Электрические свойства мемристорного устройства на основе смешанного оксида металлов
Стендовый доклад	**Сергеев И.Н.**, Хоконов А.Х., Масаев М.Б., Азматов З.А., Кумукова Ф.И.	42. Размерная зависимость краевых углов смачивания микрокаплями индия поверхности графита, интеркалированного калием
Стендовый доклад	Калмыков Р.М., Кармоков А.М., **Хатукаев Х.М.**	43. Оптические свойства пленок PbTe, допированных CdS

Дата – 5 июня 2019 г.

Секция 2. Фазовые равновесия и превращения в материалах микро- и наноэлектроники.

Краткое описание секции: Заявленные на конференцию доклады ориентированы на исследования фазовых равновесий и фазовых превращений как в объемных, так и в тонкопленочных и наноструктурированных материалах.

Председатели: Мирошникова Ирина Николаевна – д.т.н., проф. директор института НИУ МЭИ. Москва.

Рагимов Садияр Солтан оглы – д.т.н., проф. Институт Физики НАН Азербайджана, Баку

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)	ФИО докладчика	Название доклада
Пленарный доклад	Годжаев Э.М., Кахраманов К.Ш., **Кахраманов С.Ш.**, Мамедова С.И.	1. Проводящие протяженные состояния в легированном теллуриде висмута
Пленарный доклад	**Кармоков А.М.**, Молоканов О.А., Шомахов З.В., Молоканова О.О.	2. Особенности формирования стабильной нанонеоднородной структуры в стеклах, применяемых в электронике
Устный доклад	**Халилова К.Г.**, Алиева Н.А., Наджафов А.И., Абдуллаев Н.М.	3. Оствальдовское созревание в кристаллах TlGaTe2
Устный доклад	**Ткаченко К.С.**	4. Обеспечение узловой функциональной устойчивости самовосстанавливающихся деградирующих наноэлектронных компонентов
Устный доклад	**Филимонов А.В.**	5. Фазовый переход в условиях ограниченной геометрии
Устный доклад	**Старцев Ю.К.**	6. Температурные зависимости коэффициентов взаимодиффузии ионов в стекле в равновесном и изоструктурном состояниях
Устный доклад	**Юрк В.М.**, Маскаева Л.Н., Марков В.Ф.	7. Фотоэлектрические характеристики термически обработанных пленок PbSe, синтезированных в присутствии различных антиоксидантов окисления селеномочевины
Устный доклад	Кахраманов С.Ш., **Абдуллаев Н.А.**, Кахраманов К.Ш.	8. Межслоевые нанообъекты в твердом растворе Sb2Te3-Bi2Te3-Te
Устный доклад	**Чуфарова Н.А.**, Уразова К.К., Маскаева Л.Н., Марков В.Ф.	9. Формирование твердых растворов системы CdS-PbS методом ионообменного синтеза
Устный доклад	**Тагиев** В., Ганрывердиев В., Абдуллаев М., Керимова Г.	10. К теории фазовых переходов в изинговых магнитных сверхрешеточных нанотрубках
Устный доклад	**Рембеза С.И.**, Винокуров А.А., Рембеза Е.С.	11. Влияние примеси Al на свойства пленок ZnO
Устный доклад	**Аккузина А.А.**, Аветисов Р.И., Аветисов И.Х.	12. Области гомогенности кристаллических металлорганических гетеролигандных люминофоров
Устный доклад	**Ризаханова С.У.**, Кардашова Г.Д.	13. Микроструктура спеченной керамики SiC-NbC

Устный доклад	**Ахмедов А.С.,** Сафаралиев Г.К., Карданова Г.Д.	14. Формирование слоев твердых растворов карбида кремния с нитридом алюминия
Устный доклад	**Абдулзаде И.И.**, Аскерова К.А., Мурсакулов И.Н., Сабзалиева Ч.Э.	15. Исследование характеристик гетероструктур GaAs/Cu(InGa)Se2/ZnO(Al)
Устный доклад	**Рабаданова А.Э.,** Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К.	16. Наноструктурированные материалы Bi1-xSmxFeO3 и Bi1-xLaxFeO3
Устный доклад	**Политова Г.А.,** Каминская Т.П., Карпенков А.Ю., Ганин М.А., Филимонов А.В.	17. Структура и фазовые переходы высокомагнитострикционного сплава SmFe2
Устный доклад	**Самканашвили Д.Г.**	18. Исследование морфологии внутренней поверхности каналов микроканальной пластины после термоводородного восстановления
Устный доклад	**Alex Laikhtman**, José I. Martínez, Hoi Ri Moon, Alla Zak, Julio A. Alonso	19. Modelling of adsorption and intercalation of hydrogen on/into tungsten disulphide multilayers and multiwall nanotubes
Стендовый доклад	**Старцев Ю.К.**	20. Физический смысл параметров релаксационной модели структурной релаксации
Стендовый доклад	**Зажогин А.П.,** Чинь Н. Х., Патапович М.П., Булойчик Ж.И.	21. Синтез нанокластеров оксидов цинка легированных медью из ортофосфатных солей в пористых образцах при лазерной абляции
Стендовый доклад	**Фомин В.М.,** Кобелева С.П., Анфимов И.М., Юрчук С.Ю., Турутин А.В.	22. Особенности диффузии фосфора в сильно легированном галлием германии
Стендовый доклад	**Мясниченко В.С.**, Сдобняков Н.Ю., Колосов А.Ю., Неша Н.И., Щербатых К.Р.	23. Моделирование процессов диффузии вблизи раздела металлов в кобальтсодержащих наносистемах
Стендовый доклад	**Мясниченко В.С.**, Сдобняков Н.Ю., Ершов Н.С., Цепягина Ю.Н., Давыденкова Е.М.	24. Моделирование формирования кристаллических фаз в модельных биметаллических системах на основе титана
Стендовый доклад	**Антонов А.С.,** Иванов Д.В., Сдобняков Н.Ю., Мясниченков В.С.	25. О доминирующих механизмах при формировании островковых пленок, обладающих фрактальными свойствами профиля и поверхности
Стендовый доклад	**Агаев Т.Н.**, Меликова С.З.	26. Исследование кинетики и механизма образования молекулярного водорода при радиолизе воды в системе нано-ZrO2 + нано-SiO2
Стендовый доклад	**Сарыева Р.Х.,** Маскаева Л.Н.	27. Зависимость структуры тонких пленок PbSnS от вводимых галогенов
Стендовый доклад	**Мустафаева Д.Г.,** Мустафаев Г.А.	28. Получение, свойства и применение халькогенидов металлов
Стендовый доклад	**Шебзухов М.Д.**	29. Исследования поверхностного натяжения бинарной системы натрий-цезий
Стендовый доклад	**Сердобинцев А.А.,** Стародубов А.В., Кожевников И.О., Галушка В.В.	30. Структура и свойства тонкопленочных резистивных покрытий оксида олова

Стендовый доклад	**Сергеев И.Н.,** Хоконов А.Х., Ахматов З.А.	31. Измерение межфазного натяжения микролитровых капель галлия на границе с водой методом капиллярных колебаний
Стендовый доклад	**Дышекова А.Х.,** Нагаплежева Р.Р., Кармоков А.М.	32. Межфазное взаимодействие на границе щелочногалоидных кристаллов с расплавом свинца
Стендовый доклад	**Хатукаев Х.М.,** Маремкулов З.А., Молоканов О.А., Кармоков А.М.	33. Формирование проводящей пленочной матричной структуры на поверхности пироэлектрика ТГС
Стендовый доклад	**Калмыков Р.М.,** Кармоков А.М.	34. Влияние примесей CdS в PbTe на его электрофизические свойства

Дата – 6 июня 2019 г.

Секция 3. Технологии наноматериалов и тонкопленочных структур для микро- и наноэлектроники.

Краткое описание секции: Заявленные на конференцию доклады ориентированы на создание новых диэлектрических, полупроводниковых и проводниковых материалов, включая фотонные кристаллы, нанопористые материалы и нанокластеры.

Председатели: Рембеза Станислав Иванович – д.ф.-м.н., проф., Воронежский государственный технический университет, Воронеж

Кармоков Ахмед Мацевич – д.ф.-м.н., проф., Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)	ФИО докладчика	Название доклада
Пленарный доклад	**Гуляев А.М.**, Сарач О.Б. НИУ МЭИ, Москва	1. Газовые сенсоры. Настоящее и будущее
Пленарный доклад	**Сафаралиев Г.К.**	2. Оценка влияния технологических режимов плазменно-искрового спекания керамики на основе карбида кремния на плотность получаемых образцов
Устный доклад	**Багиров С.Б,** Кахараманов С.Ш.	3. Халькогениды висмута и сурьмы с межслоевыми наноструктурами и разработка термоэлементов на их основе
Устный доклад	Абдуллаев Н.А., Азимова С.Р., Алиев О.А., **Джафарли К.М.**, Кахраманов С.Ш., Кахраманов К.Ш., Абдуллаев Н.М.	4. Тепловое оствальдовское созревание эвтектик термоэлектрических систем $A^{IV}B^{VI}$
Устный доклад	**Туленин С.С.**, Баранова К.А., Бунаков В.В.	5. Получение и исследование тонких полупроводниковых пленок сульфида индия(III)
Устный доклад	**Матюшкин И.В.**, Литаврин	6. Метод направленной самосборки в литографии проектных норм менее 22 нм
Устный доклад	**Эминов Ш.О.**, Гасанов И.С., Мусаева Н.Н., Абдуллаева С.Х., Джалилова Х.Д., Гулиев Д.А., Исмаилов Н., Раджабли А.А.	7. Синтез и морфология TiO2 наноструктур, полученных анодным окислением

Устный доклад	**Беглецова Н.Н.**, Селифонова Е.И., Чернова Р.К., Вениг С.Б., Глуховской Е.Г.	8. Мультидисперсные частицы меди, полученные с использованием поверхностно-активного вещества
Устный доклад	**Зажогин А.П.**, Чинь Н. Х., Патанович М.П., Булойчик Ж.И.	9. Процессы при напылении тонких пленок оксида олова на поверхность стекла сериями сдвоенных лазерных импульсов
Устный доклад	Воропай Е.С., **Баззал Ходор**, Зажогин А.П., **Лычковский В.В.**	10. Исследования влияния формы канала на процессы образования AlN в плазме при воздействии серий сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевую мишень в воздушной атмосфере
Устный доклад	**Сердобинцев А.А.**, Кожевников И.О.	11. Лазерная взрывная литография кремниевых пленок на изолирующих подложках
Устный доклад	**Курмашев В.И.**	12. Гетерогенные наноструктурированные магнитные материалы для создания компонентов МЭМС
Устный доклад	**Хазанов А.А.**, Цветкова О.Ю.	13. Управление размерами при фотохимическом синтезе квантоворазмерных частиц полупроводников
Устный доклад	**Растворова И.И.**, Денисова О.В.	14. Модификация поверхности графита методом ALD
Устный доклад	**Белых М.А.**, Пермяков Д.С., Полковников В.Е.	15. Методы синтеза пленок ZnO:Al и исследование их свойств.
Устный доклад	**Полковников В.Е.**, Пермяков Д.С., Белых М.А., Рембеза С.И.	16. Синтез металлооксидных пленок методом спрей-пиролиза
Устный доклад	**Пермяков Д.С.**, Белых М.А., Полковников В.Е., Рембеза С.И.	17. Синтез и физические свойства пленок оксида меди
Устный доклад	**Агаев Т.Н.**, Мусаева Ш.З.	18. Влияние гамма излучения на выход водорода при радиолизе гексана на поверхности нано-ZrO_2
Устный доклад	**Стецюра С.В.**, Козловский А.В., Масленникова А.А.	19. Влияние освещения на формирование органического наноразмерного покрытия на кремниевой структуре при различной ионной силе раствора
Устный доклад	**Козловский А.В.**, Стецюра С.В., Светлицына И.А.	20. Влияние диэлектрического и буферного слоев на электрофизические характеристики биосенсорной структуры
Устный доклад	**Смирнов Г.В.**, Коваль Н.Н., Екимова И.А., Ковальский А.В., Рустамбек У.	21. Ионно-плазменные технологии для формирования структуры поверхности зубных имплантов
Устный доклад	**Перинская И.В.**, Родионов И.В., Перинский В.В.	22. Ионно-лучевое нанокконструирование слоев арсенида галлия для резисторов интегральных схем
Устный доклад	**Каменцев А.С.**, Петров В.В., Рожко А.А.	23. Технологические особенности формирования тонких пленок ЦТС
Устный доклад	**Оруджев Ф.Ф.**, Рамазанов Ш.М.	24. Мемристивный материал на основе $BiFeO_3/TiO_2$(NT)/Ti
Устный доклад	**Палчаев Д.К.**, Гаджиев М.Х.	25. Плазменная обработка поверхности наноструктурированной керамики $YBa_2Cu_3O_{7-y}$

Стендовый доклад	Эмиров Р.М., Рабаданов М.Х., **Гаджимагомедов С.Х.**	26. Синтез нанопорошков оксидов железа
Стендовый доклад	**Рамонова А.Г.**, Шанаева А.Т., Туриев А.М.	27. Влияние лазерного излучения на морфологию и десорбционные свойства органических пленок
Стендовый доклад	**Козырев Е.Н.**, Аскеров Р.О., Мерзлов В.С., Ширяев А.В., Асланов М.А.	28. Свойства фотонных кристаллов на основе анодного оксида алюминия с пористой структурой, заполненной сегнетоэлектриком
Стендовый доклад	**Асланов М.А.**, Дедегкаева Л.М.	29. Исследование образцов пленок пористого оксида алюминия, полученных в вертикально ориентированном электрическом поле
Стендовый доклад	**Иванова А.А.**, Туриев А.М.	30. Исследование оптических свойств пленок осажденных из сложных растворов фталоцианинов редкоземельных элементов
Стендовый доклад	**Кодзасова Т.Л.**, Кабулова Т.А., Кодзасов В.А., Асланов М.А., Собанов В.Х.	31. Исследование многослойных фотонных кристаллов при внедрении в поры оксида алюминия нитрита натрия.
Стендовый доклад	Аскеров Р.О., Мерзлов В.С., **Датиев К.М.**	32. Двулучепреломление в фотонных кристаллах на основе анодного пористого оксида алюминия
Стендовый доклад	Рамонова А.Г., **Шанаева А.Т.**, Туриев А.М.	33. Влияние лазерного излучения на морфологию и десорбционные свойства органических пленок
Стендовый доклад	Березов А.В., **Валиева Д. И.**, Туриев А.М.	34. Фотолюминесценция тонких пленок фталоцианина никеля
Стендовый доклад	Черкесова Н.В., Мустафаев А.Г., Мустафаев Г.А.	35. Пленки нитрида тантала в качестве материала диффузионного барьера в контактной системе металлизации

Дата –7 июня 2019 г.

Секция 4. **Приборы и устройства; информационные технологии в микро- и наноэлектронике**.

Краткое описание секции: Заявленные на конференцию доклады посвящены вопросам разработки новых приборов и устройств электроники, фотоники и оптоэлектроники, а также моделирования различных физических явлений, функциональных структур, технологических воздействий на материалы и структуры элементов электроники.

Председатели: Смирнов Александр Георгиевич – д.т.н., проф. зав. лаб. БГУИР, Минск
Гуляев Александр Михайлович – д.ф.-м.н., проф., Московский энергетический институт, Москва

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)	ФИО докладчика	Название доклада
Пленарный доклад	**Мирошникова И.Н.**, Мирошников Б.Н., Мухамедьяров Р.Д., Зезин Д.А. НИУ МЭИ, Москва	1. Фотоэлектрические приемники среднего ИК-излучения: очерк развития
Пленарный доклад	**Потапов А.А.** профессор ГПС ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, (Москва).	2. Современные информационные технологии в радиоэлектронике на основе теории фракталов, текстур, дробного анализа и методов нелинейной динамики (40 лет научных разработок)

Устный доклад	**Потапов А.А.**	3. Канторовские множества во фрактальных микро- и нанотехнологиях
Устный доклад	**Матюшкин И.В.**, Кожевников	4. Алгоритм генерации псевдослучайных чисел с помощью клеточных автоматов
Устный доклад	Матюшкин И.В., **Кожевников**, Черняев	5. Физико-статистический подход к вопросам надежности наноприборов
Устный доклад	Родионов Ю.А., Смирнов А.Г., Степанов А.А., **Муха Е.В.**	6. Микроэлектронный датчик влажности
Устный доклад	**Родионов Ю.А.**, Смирнов А.Г., Степанов А.А., Муха Е.В.	7. Микроэлектронный датчик радиоактивности
Устный доклад	**Замятин Н.В.**, Смирнов Г.В.	8. Нейросетевые калибраторы для средств измерения и контроля в технологических процессах нано- и микроэлектроники
Устный доклад	**Гончаров И.Н.**, Козырев Е.Н., Аскеров Р.О.	9. Особенности формирования промежуточного фотокатода в многокамерном электронно-оптическом преобразователе
Устный доклад	**Стецюра С.В.**	10. Моделирование вольт-фарадной характеристики биосенсорной структуры, полученной в условиях фотоассистирования
Устный доклад	**Стецюра С.В.**	11. Моделирование вольт-фарадной характеристики биосенсорной структуры, полученной в условиях фотоассистирования
Устный доклад	**Савенко В.И.**	12. Влияние электронной тренировки на свойства и состав резистивно-эмиссионного слоя и коэффициент вторичной электронной эмиссии микроканальных пластин
Устный доклад	**Алиханов А.Р.**	13. Разработка автоматизированной программы для измерения параметров микроструктуры МКП
Устный доклад	**Кривов С.В.**, Гусалов А.И.	14. Моделирование температурных и газогидродинамических процессов в печи установки вытяжки многожильных световодов
Устный доклад	**Воропаев К.О.**, Селезнев Б.И., Ионов А.С., Петров А.В.	15. Особенности технологии изготовления вертикально-излучающих лазеров с длиной волны генерации 1,55 мкм
Устный доклад	**Волхонский В.В.**, Малышкин С.Л.	16. Подход к снижению вероятности ложного срабатывания пассивных оптико-электронных инфракрасных датчиков движения
Устный доклад	**Ткаченко А.В.**, Лысенко И.Е.	17. Механизмы накопления заряда в диэлектрических слоях емкостных МЭМС-переключателей
Устный доклад	**Федоров Д.Г.**, Селезнев Б.И. Петров М.П.	18. Моделирование диодов Шоттки на GaN
Устный доклад	**Желанов А.В.**, Селезнев Б.И., Федоров Д.Г.	19. Разработка технологии изготовления и исследование транзисторов на основе нитрида галлия
Устный доклад	**Мосиян Д.С.** Гавриков М.В. Жуков Н.Д.	20. Вторичная эмиссия в квантовых точках и ее приборное использование

Стендовый доклад	Мясниченко В.С., **Сдобняков Н.Ю.**, Ершов П.С., Цепягина Ю.Н., Давыденкова Е.М.	21. Моделирование формирования кристаллических фаз в модельных биметаллических системах на основе титана
Стендовый доклад	**Мустафаев Г.А.**, Мустафаева Д.Г.	22. Формирование микроэлектронных приборных структур с заданными свойствами
Стендовый доклад	Мустафаев Г.А., **Мустафаева Д.Г.**	23. Совершенствование и регулирование технологии изготовления изделий электроники.
Стендовый доклад	**Варзарев Ю.Н.**, Каменцев А.С., Петров В.В.	24. Стенд для исследования электрофизических параметров тонких пленок ЦТС
Стендовый доклад	**Михайлова О.Н.**, Корляков А.В., Лагон А.В.	25. Исследование свойств полимерных материалов для параметрических преобразователей
Стендовый доклад	**Гусалов А.И.**, Кулова Н.С., Кабышев О.А.	26. Разработка базовой технологии изготовления высокоплотных микролуночных матриц на основе волоконно-оптических технологий, используемых в качестве основы биочипов для молекулярно-биологической диагностики
Стендовый доклад	**Кабышев О.А.**	27. Разработка автоматизированной программы для измерения глубины запыления контактного электрода на торцах микроканальной пластины
Стендовый доклад	**Павлов А.Ю.**	28. Сравнение частотных характеристик HEMT AlGaN/GaN, изготовленных по 0,25 мкм технологии со сплавными и несплавными омическими контактами.
Стендовый доклад	**Ширяев А.В.**, Мерзлов В.С.	29. Тензорезисторный датчик малых возмущений
Стендовый доклад	Дедегкаева Л.М., **Хасцаев Б.Д.**	30. Автоматизированное устройство для определения микрокомпонентов жидких сред
Стендовый доклад	**Атаев Я.Ф.**, Созаев В.А., Датиев К.М.	31. Разработка и исследование холловских датчиков малых магнитных полей на полевых транзисторах с барьером Шоттки
Стендовый доклад	**Салказанов А.Т.**, Датиев К.М.	32. Компьютерное моделирование параметров структуры солнечных элементов
Стендовый доклад	Козырев Е.Н., **Сабанов В.Х.**, Гончаров И.Н., Гордеев Г.О., Кучиев Т.Е., Галачиева С.В.	33. Преобразователь солнечной энергии на основе перовскитов и неорганических полупроводников
Стендовый доклад	**Шебзухов М.Д.**	34. Стеклянный прибор для построения диаграммы плавкости индий-цезий, индий-калий
Стендовый доклад	Родионов Ю.А., **Андрущенко А.И.**	35. Защита ГИС от воздействия излучений РЭБ
Стендовый доклад	Родионов Ю.А., **Кравчук М.Б.**	36. Датчик Виганда
Стендовый доклад	**Басов М.В.**	37. Исследование высокочувствительного кристалла датчика давления на основе биполярного транзистора
Стендовый доклад	Гуляев А.М., **Сарач О.Б.**, Калинкин А.С., Апуфриев Ю.В.	38. Газовые сенсоры на основе нанокристаллических пленок диоксида олова. Метрика и применение
Стендовый доклад	**Гуляев А.М.**	39. Микроэлектронные газовые сенсоры на основе нанокристаллических пленок диоксида олова

Стендовый доклад	**Павлов А.М.**, Галушка В.В., Корнунова Г.А., Городков С.Ю., Сердобинцев А.А.	40. Имплантируемое микроэлектронное устройство для стимуляции периферических нервных окончаний
Стендовый доклад	**Писарев А.Д.**, Бусыгин А.Н., Удовиченко С.Ю.	41. Принципы импульсного кодирования цифровой информации в сверхбольших мемристорных кроссбарах для применений во входном блоке нейропроцессора
Стендовый доклад	**Хоконов Х.Б.**, Тегаев Р.И., Хоконов А.Х., Сергеев И.Н.	42. Электронный проектор для определения поверхностного натяжения сильно искривленных интерфейсов статическим методом
Стендовый доклад	Черкесова Н.В., Мустафаев А.Г., Мустафаев Г.А., **Блиева А.З.**	43. КМОП-структура с инверсными карманами
Стендовый доклад	Черкесова Н.В., **Мустафаев А.Г.**, Мустафаев Г.А.	44. Деградация параметров МДП-транзисторов воздействием горячих носителей
Стендовый доклад	Дедков Г.В., **Бельгушева Л.П.**, Макаева Л.М.	45. Измерения адгезионых сил на микроскопе Solver-Pro

Круглый стол: Достижения и перспективы развития микро- и нанотехнологий в электронике. Награждение победителей конкурса молодых ученых, аспирантов и студентов. Обсуждение проекта и принятие Решения конференции.
Закрытие конференции.

8 июня 2019 г.

Отъезд участников конференции.

Председатель программного комитета Альтудов Ю.К.